## 2023 年

2023-J1(C)

インピーダンス計測プラットフォーム技術を用いた SiN 膜中トラップ特性の統計的計測 第 28 回電子デバイス界面テクノロジー研究会(応用物理学会 薄膜・表面物理分科会,シリコンテクノロジー分科会 共催),pp.89-94,2023 年 2 月 4 日,静岡県三島市齊藤宏河,鈴木達彦,光田薫未,間脇武蔵,諏訪智之,寺本章伸,須川成利,黒田理人 https://tsys.jp/oxide/2023/program.html

2023-J2(C)

ランダムテレグラフノイズの MOSトランジスタ構造・動作条件依存性の統計的解析 第 28 回電子デバイス界面テクノロジー研究会(応用物理学会 薄膜・表面物理分科会,シリコンテクノロジー分科会 共催),pp.141-145,2023 年 2 月 4 日,静岡県三島市 間脇武蔵,黒田理人,秋元瞭,須川成利 https://tsys.jp/oxide/2023/program.html